

Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0212U000171

Державний реєстраційний номер: 0111U001021

Відкрита

Дата реєстрації: 20-01-2012



1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Нанорозмірні механізми радіаційно-структурних змін у модельних сполуках та бінарних системах ХСН

Початок етапу: 01-2011

Закінчення етапу: 12-2011

Вид звітнього документа: Проміжний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125438

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24

Телефон: (03-244) 3-33-32, 3-81-11

E-mail: administrator@drohobych.net

WWW: www.drohobych.net

Інше: ddpu

Інше:

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125438

Адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24

Підпорядкованість: Міністерство освіти України

Телефон: (03-244) 3-33-32, 3-81-11

E-mail: administrator@drohobych.net

WWW: www.drohobych.net

Інше: ddpu

Інше:

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 2201020

Напрямок фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 50.8 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Нанорозмірні механізми радіаційно-структурних змін у халькогенідних склоподібних напівпровідниках

Назва роботи (англ)

Nanoscale mechanisms of the radiation-structural changes in chalcogenide vitreous semiconductors

Реферат (укр)

Досліджено радіаційно-структурні зміни у модельних сполуках та бінарних системах халькогенідних склоподібних напівпровідників (ХСН) методом вимірювання магнітної сприйнятливості і методом вимірювання часів життя анігіляційних позитронів у комбінації з вимірюванням Допплерівського розширення фотопіку 511 keV. З'ясовано, що має місце зростання структурної неупорядкованості та зменшення концентрації порожнинних дефектів після γ -опромінення зразків ХСН.

Реферат (англ)

Radiation-structural changes in the model alloys and binary systems of chalcogenide vitreous semiconductors (ChVSs) are investigated using method of magnetic susceptibility measurement and method of positron annihilation lifetime measurement in combination with Doppler broadening measurement of the 511 keV photopeak. It is established that structural disorder increases and concentration of open-volume defects decreases upon γ -irradiation of the ChVS samples.

Індекс УДК: 537.311.322, 539.216.2

Коди тематичних рубрик НТІ: 29.19.31

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

T. Kavetsky, K. Kolev, V. Boev, P. Petkov, T. Petkova, A.L. Stepanov. Nanovoids in glasses and polymers probed by positron annihilation lifetime spectroscopy//NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, 2011, P. 103-110.

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 23

Мова звіту: Українська

Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців

Дубик Оксана Михайлівна

Зайцев Олександр Вадимович

Кавецький Тарас Степанович

Матлак Олена Сергіївна

Павлюх Наталія Степанівна

Паньків Ігор Степанович

Паньків Людмила Іванівна

Цмоць Володимир Михайлович

Керівник організації:

Кишакевич Юрій Львович

Керівники роботи:

Цмоць Володимир Михайлович

**Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ**



Юрченко Т.А.